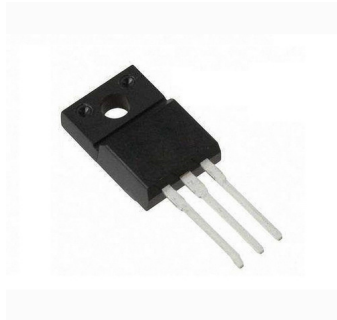


Transistor Mosfet FQPF10N60C 600V 9.5A

Codigo: **113785**



Descripción

El 10N60C es un Mosfet ha sido especialmente diseñada para minimizar la resistencia en el estado, proporcionar un rendimiento de conmutación superior y soportar pulsos de alta energía en el modo de conmutación y avalancha. Estos dispositivos son adecuados para suministros de energía de modo de conmutación de alta eficiencia y corrección de factor de potencia activa.

- Capacidad dv / dt mejorada
- Cambio rápido
- Carga de puerta baja (típico 44 nC)
- C_{rss} bajo (típico 18 pF)
- Polaridad del transistor: Canal N
- Voltaje de drenaje a fuente V_{DS} : 600 V
- Voltaje de puerta a fuente V_{GS} : ± 30 V
- Corriente de drenaje I_D : 9.5 A
- Corriente de drenaje pulsada: 38 A
- Disipación de potencia ($T_c=25^\circ\text{C}$): 156 W
- Resistencia de activación $R_{ds(on)}$: 0.73 ohm
- Temperatura de funcionamiento mínima: -55°C
- Temperatura de funcionamiento máxima: 150°C
- Encapsulado: TO-220F
- Número de pines: 3